



МИКРОСХЕМА КМ14УР1

Э Т И К Е Т К А

Гибридные интегральные микросхемы КМ14УР1 предназначены для использования в качестве широкополосного усилителя в блоках прямо-передней аппаратуры.

Схема расположения 1 выводов

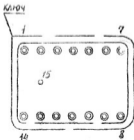


Схема электрическая принципиальная

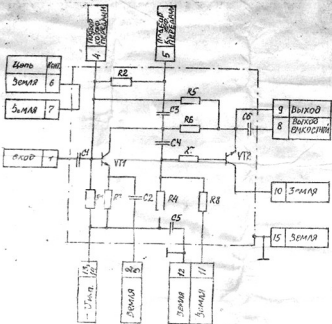
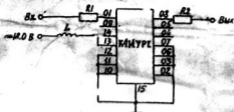


Схема члрчекн



| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|---|------|------------|
| R1, R2 | Резистор МЛТ-0,125-75 Ом±10% ГОСТ 7113-77 | 2 | |
| L | Дроссель высокочастот. инд ПЭ4.777.000 Сп Др-3,4-20±1,0 ГИ0.477.005 П | 1 | |

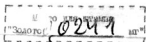
Основные электрические параметры
(при температуре окруж. мед. сред. 25 ± 10°C)

| | |
|---|-------------|
| Ток потребления (при напряжении источника питания минус 18,0 В), мА..... | 17,0 |
| Коэффициент усиления напряжения (при напряжении источника питания минус 18,0 В, частоте входного сигнала 70,0 МГц), дБ..... | 12,5 - 15,5 |
| Верхняя граничная частота (при напряжении источника питания минус 17,1 В, входном напряжении 100 мВ), МГц, не менее | 200,0 |
| Нижняя граничная частота (при напряжении источника питания минус 18,0 В, входном напряжении 100 мВ), МГц, не более | 5,0 |
| Отклонение коэффициента усиления напряжения (при напряжении источника питания минус 18,0 В, частоте входного сигнала 45,0 МГц и 95,0 МГц), дБ, не более | ± 1,0 |

Пределные значения допустимых
электрических режимов эксплуатации
(в диапазоне температур от минус 10 до +65°С)

| | |
|---|-----------------------|
| Кратковременное максимальное напряжение источника питания в течение 1 мин, В | минус 22,0 |
| Напряжение питания питания, В | минус 17,0-минус 20,0 |
| Максимальный выходной ток, мА | 5,0 |
| Максимальное входное напряжение, В эф., | 0,5 |

Содержание драгоценных металлов



ОТН-73

Указания по эксплуатации

1. Указание по применению и эксплуатации в соответствии с разделом 5 ГОСТ 18725-77.
2. Затухание продуктов нелинейности второго и третьего порядков на выходе микросхемы при испытании двухсигнальным методом с напряжением каждого из сигналов на выходе 300 мВ (частоты сигналов 50 и 65 МГц) не менее 30 дБ.
3. При работе с микросхемой необходимо предусматривать защиту микросхемы от воздействия статического электричества в соответствии с ОСТ II 073,062-76.

Предельные значения электростатического напряжения по 5 степеням жесткости.